

конкретного случая имеет свой вид. В общем случае он может быть представлен в форме, учитывающей все возможные взаимодействия парамагн. частицы (центра):

$$\hat{W} = \hat{W}_H + \hat{W}_x + \hat{W}_{ct} + \hat{W}_{cc} + \hat{W}_d + \hat{W}_E, \quad (2)$$

где  $\hat{W}_H$  описывает взаимодействие с внеш. магн. полем  $H$ ;  $\hat{W}_x$  — взаимодействие с внутрикристаллич. электрич. полем;  $\hat{W}_{ct}$  — с магн. моментом собственного и окружающих ядер (сверхтонкое взаимодействие и суперсверхтонкое взаимодействие);  $\hat{W}_{cc}$  — спин-спиновые взаимодействия парамагн. центров между собой (обменное взаимодействие, диполь-дипольное и др.);  $\hat{W}_d$  — взаимодействие с приложенным внеш. давлением  $P$  (деформациями);  $\hat{W}_E$  — с внеш. электрич. полем  $E$ . Каждое слагаемое, входящее в (2), может состоять из неск. членов, вид к-рых зависит от величины электронных и ядерных спинов и локальной симметрии центра. Часто встречающиеся выражения имеют вид:

$$\begin{aligned}\hat{W}_H &= g\beta HS; \quad \hat{W}_x = a(S_x^4 + S_y^4 + S_z^4); \\ \hat{W}_{ct} &= A(S^{(i)}I^{(k)}); \quad \hat{W}_{cc} = J(S^{(i)}S^{(k)}); \\ \hat{W}_d &= CP[S_z^2 - S(S+1)\hat{e}/3]; \\ W_E &= RE_z(\hat{S}_x\hat{S}_y + \hat{S}_y\hat{S}_x),\end{aligned}$$

где  $g$ ,  $a$ ,  $A$ ,  $J$ ,  $C$ ,  $R$  — параметры теории,  $S^{(i)}$  и  $I^{(k)}$  —  $i$ -й и  $k$ -й спины электронов и ядра;  $\hat{e}$  — единичная матрица. Спиновый гамильтониан (2) обычно относят к одному электронному или электронно-колебат. терму (обычно основному), предполагая, что другие термы отстоят от него на величину, значительно превышающую энергию кванта ЭПР-перехода. Но в ряде случаев, напр. при наличии Яна — Теллера эффекта, возбуждённые термы могут находиться достаточно близко и их необходимо учитывать при описании спектров ЭПР. Тогда для сохранения формализма спинового гамильтониана можно ввести эф. спин ( $S_{\phi}$ ), связанный с общим числом состояний всех уровней ( $r$ ) соотношением  $r = 2S_{\phi} + 1$ . Другой подход возможен в рамках метода матрицы возмущения: находится полная матрица оператора возмущения на всех состояниях учитываемых уровней.

Каждое из слагаемых (2) может быть разделено на две части: статическую и динамическую. Статич. часть определяет положение линий в спектре, динамическая — вероятности квантовых переходов, в т. ч. обусловливающих и релаксац. процессы. Энергетич. структуру и волновые ф-ции находят, решая систему ур-ний, соответствующую (2). Число ур-ний равно

$$\prod_{k=1}^n (2S_k + 1) \prod_{r=1}^p (2I_r + 1),$$

где  $n$  и  $p$  — число фигурирующих в (2) спинов электронов и ядер. Обычно  $S$  и  $I$  принимают значения от  $1/2$  до  $7/2$ ;  $n=1, 2$ ;  $p=1—50$ , что указывает на возможность существования секулярных ур-ний высокого порядка. Для преодоления техн. трудностей при диагонализации (2) используют приближённые (аналитические) расчёты. Не все слагаемые (2) одинаковы по величине. Обычно  $\hat{W}_H$  и  $\hat{W}_x$  преобладают др. члены, а  $\hat{W}_d$  и  $\hat{W}_E$  значительно меньше предыдущих. Это позволяет развить теорию возмущений в неск. этапов. Кроме того, разработаны спец. программы для ЭВМ.

Цель феноменологич. теории — нахождение для определ. перехода выражения для  $H_p$  в ф-ции параметром спинового гамильтониана и углов, характеризующих ориентацию внеш. полей относительно кристаллографич. осей. Сопоставлением  $(H_p)_{\text{теор}}$  с  $(H_p)_{\text{эксп}}$  устанавливается правильность выбора (2) и находятся параметры спинового гамильтониана.

Параметры спинового гамильтониана рассчитываются независимо с помощью методов квантовой механики, исходя из определ. модели парамагн. центра. При этом используют теорию кристаллич. поля, метод молекулярных орбиталей, др. методы квантовой химии и теории твёрдого тела. Осн. трудность этой проблемы состоит

в определении электронной энергетич. структуры и волновых ф-ций парамагн. центров. Если эти составляющие ур-ния Шредингера найдены, а операторы возмущения известны, задача сводится к вычислению лишь соответствующих матричных элементов. В силу сложности всего комплекса проблем полных расчётов параметров спинового гамильтониана проведено пока мало и не во всех из них достигнуто удовлетворит. согласие с экспериментом. Обычно ограничиваются оценками по порядку величины, используя приближённые ф-лы.

Спектр ЭПР (число линий, их зависимость от ориентации внеш. полей относительно кристаллографич. осей) полностью определяется спиновым гамильтонианом. Так, при наличии лишь зеемановского взаимодействия выражение для энергии имеет вид  $\mathcal{E}_m = g\beta H_z M$ , где  $M$  — квантовое число оператора  $S_z$ , принимающее  $2S+1$  значений:  $-S, -S+1, \dots, S-1, S$ . Магн. составляющая эл.-магн. волны в данном случае вызывает лишь переходы с правилами отбора  $\Delta M = \pm 1$ , и в силу эквидистантности уровней, в спектре ЭПР будет наблюдаваться одна линия. Нарушение эквидистантности возникает за счёт др. слагаемых спинового гамильтониана. Так, аксиально симметричное слагаемое из  $\hat{W}_x$ , характеризуемое параметром  $D$ , добавляет

$$\text{к } \mathcal{E}_m \text{ член } (\Delta \mathcal{E}_M)_k = D [M^2 - \frac{1}{3}S(S+1)], \quad H_p \text{ оказывается}$$

зависящим от  $M$ , и в спектре будет наблюдаваться  $2S$  линий. Учёт слагаемого  $AS_z I_z$  из  $\hat{W}_{ct}$  приводит к добавке  $(\Delta \mathcal{E}_M)_{ct} = AMm$ , где  $m$  — квантовое число оператора  $I_z$ ;  $H_p$  будет зависеть от  $m$ , и в спектре ЭПР будет  $27+1$  линия. Другие слагаемые из (2) могут приводить к дополнительным, «запрещённым» правилам отбора (напр.,  $\Delta M = \pm 2$ ), что увеличивает число линий в спектре.

Специфическое расщепление линий возникает под действием электрич. поля (слагаемое  $\hat{W}_E$ ). В кристаллах часто (корунд, вольфрамиты, кремний) существуют инверсионно неэквивалентные положения, в к-рых могут с равной вероятностью находиться примесные ионы. Так как магн. поле нечувствительно к операции инверсии, оно эти положения не различает, и в спектре ЭПР линии от них совпадают. Приложенное к кристаллу электрич. поле для разных неэквивалентных положений в силу их взаимной инвертированности будет направлено в противоположные стороны. Поправки к  $H_p$  (линейные по  $E$ ) от разных положений будут с противоположными знаками, и смещение двух групп линий проявится в виде расщепления.

В отсутствие магн. поля ( $\hat{W}_H = 0$ ) расщепление уровней, называемое начальным, обусловлено др. членами (2). Число возникающих уровней, кратность их вырождения зависят от величины спина и симметрии парамагн. центра. Между ними возможны переходы (соответствующее явление получило назв. бесполевого резонанса). Для его осуществления можно менять частоту  $v$  эл.-магн. излучения, либо при  $v = \text{const}$  менять расстояние между уровнями внешн. электрич. полем, давлением, изменением темп-ры.

**Определение симметрии парамагнитного центра.** Угл. зависимость  $H_p(\theta, \phi)$  отражает симметрию спинового гамильтониана, к-рая в свою очередь связана с симметрией парамагн. центра. Это даёт возможность по виду ф-ции  $H_p(\theta, \phi)$ , найденной экспериментально, определять симметрию центра. В случае высокосимметричных групп ( $O_h$ ,  $T_d$ ,  $C_{4v}$  и др.) функция  $H_p(\theta, \phi)$  обладает рядом характерных особенностей: 1) положения экстремумов для линий разных переходов совпадают; 2) расстояние между экстремумами равно  $\pi/2$  (эффект ортогональности); 3) ф-ция  $H_p$  симметрична относительно положений экстремумов и др. В случае низкосимметричных групп ( $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  и др.) все эти закономерности нарушены (эффекты низкой симметрии). Эти эффекты используются для определения структуры дефектов.

Обычному ЭПР соответствует спиновый гамильтониан, не учитывающий электрич. полей ( $\hat{W}_E = 0$ ). В него входят лишь операторы момента кол-ва движения и магн. поля. В силу их псевдовекторной природы макс. число несовпадающих спиновых гамильтонианов будет равно 11 (из 32 возможных точечных групп). Это приводит к неоднознач-